

دراسة خواص التوصيلية الكهربائية لأغشية ثانوي اوكسيد القصدير الرقيقة المعالجة بواسطة أشعة الزينون النبضية المستخدمة كعناصر تحسس للغازات.

منير هليل جدوع*
أكادارينا ستانسلافا**
ستانسلاف افانوفيج**

تاريخ قبول النشر 18/2/2009

الخلاصة:

من خلال النتائج التجريبية لهذا العمل وجدنا بان تغير الخواص والتوصيلية الكهربائية للأغشية ثانية اوكسيد القصدير مع تغير تركيز الغاز عند درجات الحرارة 0°C و 260°C و 360°C بعد عملية المعالجة بالأشعة الفوتونية تملك تطابق مع تغير تلك الخواص تحت تأثير المعالجة الحرارية الايزوثرمية. وجدنا بان معالجة أغشية SnO_2 بواسطة إشعاع مكثف بنبضات قصيرة ولمدة أجزاء من الثانية تؤثر على تبلور الأغشية وزيادة ملحوظة للتحسس بالغازات.

كلمات مفتاحية: توصيلية كهربائية، أغشية ، ثاني اوكسيد القصدير،أشعة فوتونية،تحسس،تبلور.

المقدمة:

في هذا العمل درس تأثير نبضات الإشعاع الضوئي على الخواص الفيزيائية للأغشية SnO_2 والتي تستخدم كأساس لتصنيع متحسسات الغازات والأبخار، التي يتم الحصول عليها بواسطة تقنية الطلاء بالرش Spray hydrolysis deposition method.

المواد وطرق العمل:
تم الحصول على أغشية SnO_2 بواسطة طريقة الرش لمحلول $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (40%) على أساس من الألومنيا (Al_2O_3) بدرجة حرارة 973 K - 773 بسمك يتراوح بين 1 إلى 2 ميكرومتر ومقاومة كهربائية سطحية (80) - 1800 Ohm/□)

عزلت أغشية SnO_2 بواسطة نبضات إشعاع في الهواء بواسطة مصباح من الزينون بطول موجي (nm) 1600 - 200 مع مدة للتبضة الواحدة 0.3 ثانية من خلال منظومة UOL P-1 الموجودة في احدى مختبرات قسم أشباه الموصلات في جامعة فارونيش التكنولوجية في روسيا الاتحادية حيث أجرينا هذه القياسات للنماذج.

طريقة وأسلوب المعالجة للنماذج موضح في الجدول رقم (1)

إن أغشية SnO_2 المتعددة التبلور تستخدم بشكل واسع في تصنيع بساط التحسس في متحسسات الأبخار والغازات [1]. تعتمد تحسس أغشية SnO_2 للغازات اعتماد كبير على الحجم الحبيبي للأغشية فكلما كان الحجم الحبيبي صغير كلما كانت درجة تحسس هذه الأغشية كبيرة للغازات، ويرجع السبب في ذلك إلى التغير في توزيع الشحنة الكهربائية على سطح غشاء SnO_2 والغير الحالى في المقاومة الكهربائية للغشاء عنصر التحسس [2]. إن الحجم الحبيبي Polycrystalline film يعتمد على درجة الحرارة وشروط التبلور للغشاء [3].

عند المعالجة الحرارية الايزوثرمية isotherm لدرجة حرارة عالية سوف تؤثر ليس فقط على درجة التحسس للغازات وكذلك على الأساس substrate وجميع أجزاء المحتسب. إن هذا من الممكن أن يؤدي إلى ظهور عمليات حرارية مختلفة في الغشاء والأساس substrate، على سبيل المثال : يؤثر على سرعة انتشار الذرات و الفاعل الكيميائي المتبادل بين سطح الغشاء و عناصر المحتسب مع الهواء المحيط. المعاملة الحرارية على شكل نبضات بواسطة إشعاع من مصباح زينون. بمعامل امتصاص عالي (cm⁻¹) - 10^{51} - 10^4 (α)، هذا يعني بان معظم الفيض للإشعاع سوف يمتص من قبل غشاء SnO_2 بعمق 10^{-3} cm (~). ان تعرض غشاء SnO_2 لنبضات سريعة (قصيرة المدة الزمنية) سوف يقلل من فاعلية عمليات الانتشار على الحدود الفاصلة بين غشاء SnO_2 والأساس Substrate وبين حبيبات المتعددة التبلور في ما بينها.

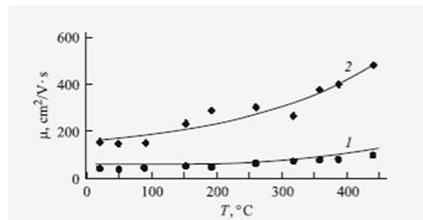
*جامعة واسط / كلية الطوطم

**جامعة فارونيش التكنولوجية / روسيا الاتحادية
693

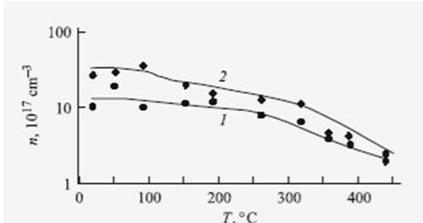
لوحظ بأنه عند درجة الحرارة $T \approx 600^{\circ}\text{C}$ سوف تحصل على انخفاض قليل القيمة للمقاومة الكهربائية السطحية، وان الاستقرار في المقاومة الكهربائية سوف يحصل بعد أول نبضة ولمدة 0.3 sec.

من خلال ما سبق درسنا في البداية النماذج التي تعرضت للتشعيع عند درجات الحرارة (600°C) (بعد نبضة واحدة لمدة 0.3 sec) و (530°C) (بعد نبضتين ولمدة 0.3 sec). التي سوف يتم توضيح الخواص الفيزيائية لاحقاً.

إن خواص التغير في الحركة μ للشنادات الحرة بالاعتماد على درجة الحرارة بعد عملية التشعيع بالأشعة الفوتونية وعند درجات الحرارة 600°C و 530°C التي يوضحها الشكل رقم (1) تتطابق مع خواص تغير الحركة μ Mobility للشنادات الحرة بعد المعاملة الحرارية الثابتة (Isotherm treatment) (Isotherm treatment) في نفس درجات الحرارة 600°C و 530°C . حيث إن زيادة الحرارة لحملات الشحنة الحرة مع ارتفاع في درجة الحرارة من الممكن أن يكون ناتج من تشتت حاملات الشحنة على أيونات الشوائب الداخلة في تركيب مادة الغشاء [4]. لكن لتحديد هذا السلوك يتطلب دراسة خاصة في هذا الموضوع تتطلع بان تقوم بها في بحث لاحقة.



شكل (1): اعتماد الحركة μ لحملات الشحنة الحرية على درجة الحرارة لاغشية SnO_2 بعد التعرض للأشعة الفوتونية : 1- عند درجة حرارة 530°C (~ بعد نبضتين ولمدة 0.3 sec), 2- عند درجة حرارة 600°C (~ بعد نبضة واحدة لمدة 0.3 sec).



شكل (2): العلاقة بين تركيز حاملات الشحنة الحرية بالاعتماد على درجة الحرارة لاغشية SnO_2 بعد التعرض للأشعة الفوتونية : 1- عند درجة حرارة 530°C (~ بعد نبضتين ولمدة 0.3 sec), 2- عند درجة حرارة 600°C (~ بعد نبضة واحدة لمدة 0.3 sec).

جدول (1): فترات المعالجة للنماذج المستخدمة.

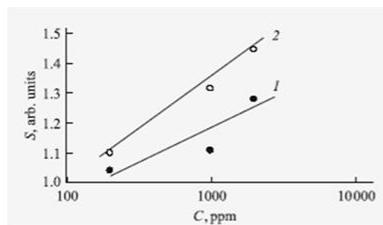
رقم النموذج	درجة الحرارة $^{\circ}\text{C}$.	فترات النبضة. Sec	القدرة Watt/cm ² .
1	400	0.3 (x 3)	8
2	465	0.3 (x 2)	9
3	530	0.3 (x 2)	10
4	600	0.3	12

قبل وبعد تشعيع النماذج أجريت قياس المقاومة الكهربائية للأغشية في مدى درجة حرارة -20°C إلى 400°C بطريقة الأقطاب الأربع. وكذلك تم قياس تركيز وحركة حاملات الشحنة الحرية. التحسين للغشاء تحت تأثير الغاز التي تحدده العلاقة $S=R_g/R_i$ حيث $S=R_g/R_i$ تمثل مقاومة الغشاء في الهواء و R_g تمثل مقاومة الغشاء عند وجود الغاز المدروس (الكحول الأثيلي). معامل الفافية للأغشية تم قياسه بواسطة مقياس الطيف نوع SF-16.

النتائج والمناقشة:

لدراسة تأثير المعاملة الفوتونية النبضية على الخواص الالكتروفيزيائية لاغشية للأغشية البصرية والكهربائية للأغشية قبل وبعد تعریض النماذج للتشعيع. مكنتنا نتائج قياسات الفافية البصرية α قبل وبعد المعالجة بالتشعيع من اختيار درجة الحرارة وفترات اللازمة للالمعالجة للنماذج النبضية للتشعيع والمعالجة الحرارية. عند تعریض نماذج الأغشية موضوع الدرس لنبضات متكررة عند درجات الحرارة 530°C , 465°C , 400°C درجة مئوية للاحظنا بأن الفافية البصرية لا تتغير بشكل ملحوظ. حيث يصل معامل الفافية إلى قيمة مستقرة عند درجة الحرارة 400°C وبعد فقط ثلات نبضات تشعي (لمدة 0.3 sec) لكل نبضة (~ بعد درجات الحرارة 465°C و 530°C). بعد نبضتي تشعي (لمدة 0.3 sec لكل نبضة). إما في حالة النموذج رقم 4 للاحظنا ان في حالة التشعيع الفوتوني عند درجة حرارة 600°C نحصل على استقرار للخواص البصرية عند أول نبضة ولمدة 0.3 sec.

لقد أجريت دراسة اعتماد تغير المقاومة الكهربائية السطحية لاغشية SnO_2 مع درجة الحرارة قبل وبعد المعالجة التشعيعية عند درجات حرارة مختلفة. تحليل البيانات التجريبية أوضحت لنا بأن التشعيع عند درجة حرارة $T \approx 400^{\circ}\text{C}$ يؤدي إلى استقرار المقاومة الكهربائية السطحية عند التشعيع لثلاث مرات ولمدة 0.3 sec لكل نبضة بينما يحدث الاستقرار في المقاومة الكهربائية في درجات الحرارة $T \approx 465^{\circ}\text{C}$ و $T \approx 530^{\circ}\text{C}$ بعد النبضة الثانية وبمدة 0.3 sec لكل نبضة. لكن



شكل (4): حساسية أغشية ثانوي SnO_2 لابخرة الكحول الأثيلي قبل (1) المعالجة بالأشعة الفوتونية وبعد المعالجة لنسبة واحدة من الاشعة الفوتونية (2) عند المعاملة الحرارة درجة حرارة 600°C (نموذج رقم 4).

بعد التشعيع بالأشعة الفوتونية درجة التحسس الغازي للأغشية تزداد (بمعدل 15%)، لكن هذه النتائج واضحة بصورة أكثر عند المعاملة الحرارية في درجة حرارة $T=600^\circ\text{C}$ وبعد شعاعي بنسبة واحدة ولمدة 0.3 sec. أما في حالة المعاملة الحرارية للأغشية عند درجة حرارة $T=530^\circ\text{C}$ فإن استقرارية أو ثبات النتائج تحصل بعد إجراء شعاعي ولمرتين (بنصتين ولمدة 0.3 sec. كل نبضة).

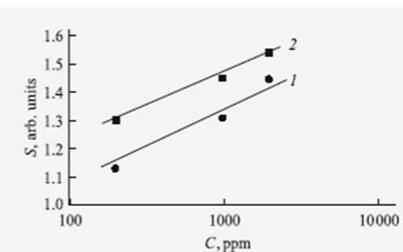
تم دراسة خواص تأثير ايونات الغاز المدروس (الكحول الأثيلي) مع الأوكسجين المنتص من على سطح الأغشية. إن تركيز حاملات الشحنة الحرارة وكذلك حركة حاملات الشحنة الحرارة في حالة تفاعل الغاز المدروس مع الأوكسجين المنتص من على الغشاء وبصيغة O^- (عند درجة حرارة 260°C) تزداد طردياً مع زيادة تركيز الغاز بمقدار القوة $1/2$ حسب العلاقة $(\alpha c^{1/2}, \mu\alpha c^{1/2})$ (n)، أما قيمة التوصيلية الكهربائية للغشاء فإنها بدورها تزداد زيادة طردية خطية مع زيادة تركيز الغاز حسب العلاقة (σ_{ac}^1) . إذا كان تفاعل الأوكسجين يحدث بصيغة O^{2-} (عند درجة الحرارة 360°C ~)، فإن قيم كل من تركيز وحركة حاملات الشحنة الحرارة والتوصيلية الكهربائية سوف تخضع للعلاقات التالية $(\sigma_{ac}^{1/3}, \mu\alpha c^{1/3})$ ، هذا يعني بسبب اعتماد الخواص الكهربائية للأغشية مع تركيز الغاز عند درجة الحرارة هذه (360°C) من الممكن تقدير دور الايونات المختلفة للأوكسجين في عملية التفاعلات مع الغاز الخاضع للدراسة.

لاختبار الصيغ الخاصة بتفاعل ايونات الغاز مع سطح الأغشية تم إجراء دراسات تجريبية لدراسة تغير الخواص الكهربائية والفيزيائية للأغشية SnO_2 SnO₂ بواسطة منظومة قياس ظاهرة هول (Hall Effect) باستخدام حجرة خاصة (Chamber) تحوى الغاز المدروس. حيث تمت دراسة تغير كل من تركيز n وحركة μ حاملات الشحنة الحرارة

إن العلاقة في تغير تركيز حاملات الشحنة الحرارة بالإعتماد على درجة الحرارة بعد عملية التشعيع بالأشعة الفوتونية وعند درجات الحرارة 600°C و 530°C التي يوضحها الشكل رقم (2)، حيث نستطيع ان نلاحظ بأنه في مدى درجات الحرارة $200 - 20$ ، ان التغير في تركيز حاملات الشحنة عملياً يبقى ثابتة. مع ارتفاع درجة الحرارة لأعلى من 200°C كذلك يمكن أن نلاحظ انخفاض في تركيز حاملات الشحنة بصورة منتظمة مماثل في لما هو في أغشية SnO_2 في حالة المعاملة الحرارية الأيزوثرمي [5]. هذه الظاهرة من الممكن ان تكون مرتبطة مع ميكانيكية امتصاص الأوكسجين من الهواء المحيط من قبل غشاء SnO_2 . حيث نستطيع توضيح ذلك كما يلي: ان امتصاص الأوكسجين من خلال سطح غشاء SnO_2 يكون بثلاث أنواع من

جزيئات الأوكسجين: O^- , O^{2-} , O_2 . التحول من صيغة إلى صيغة أخرى من صيغ الأوكسجين يعتمد على درجة الحرارة ونوع التفاعل، على سبيل المثال في درجات الحرارة أعلى من 150°C تضفي الصيغة O^{2-} , وفي الحالات التي يتطلبها انتقال الكترونات من نطاق التوصيلية إلى الحالة السطحية سوف يؤدي إلى انخفاض في تركيز حاملات الشحنة في غشاء SnO_2 ، وإن هذا مطابق للمعطيات التجريبية لعملنا هذا وكذلك يطابق ما توصل إليه الباحث في العمل [6].

ان تأثير التشعيع بالأشعة الفوتونية على درجة التحسس الغازي للأغشية SnO_2 يعتبر من أهم الأسلحة التي يجب الاهتمام بدراستها في عالم هذا، لأن ذلك يعترف من الخواص الأساسية لعمل منتجات الغازات المصنوعة من أغشية أشباه الموصلات، حيث تم دراسة تأثير التشعيع بالأشعة الفوتونية على التحسس الغازي قبل وبعد التشعيع. النتائج موضحة في الشكل 3 و 4.



شكل (3): حساسية أغشية ثانوي SnO_2 لابخرة الكحول الأثيلي قبل (1) المعالجة بالأشعة الفوتونية وبعد المعالجة لنسبة من الاشعة الفوتونية (2) عند المعاملة الحرارة درجة حرارة 530°C (نموذج رقم 3).

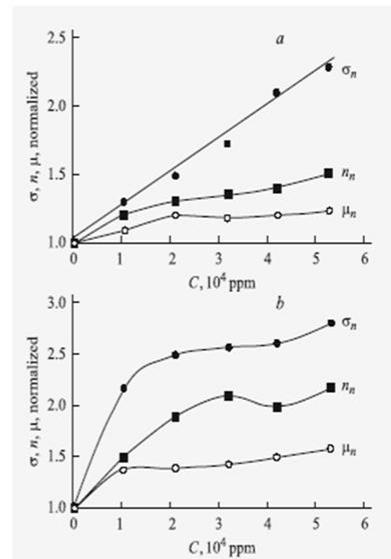
الحرارة $^{\circ}\text{C}$ 260 و 360 بعد عملية المعالجة بالأشعة الفوتونية تملك تطابق مع تغير تلك الخواص تحت تأثير المعالجة الحرارية الأيزوثرمية من خلال هذا نستطيع أن نتوصل إلى أن تأثير المعالجة الإشعاعية الفوتونية والمعالجة الحرارية الأيزوثرمية ليس لها دور في تغير ميكانيكية تحس الأغشية وإنما زيادة حساسية هذه الأغشية من المرجح أن يعود على حساب تقليل الحجم الحبيبي للغشاء متعدد النبلور.

المصادر:

- 1- Hagermark K.I., 1982. Some basic aspects of semiconductor gas sensor. *J. Appl. Phys.* 54. : 3825 – 3831.
- 2- Gopel W., Schierbaum K.D. 1995. SnO_2 sensor: current status and future prospects. *Sensor and Actuators*. 26 (2): 1–2.
- 3- Yamazoe N., Tamaki C. Xu, Miura J., N.. 1990. Relationship between gas sensitivity and microstructure of porous SnO_2 . *J. Electrochem. Soc.* 58(12): 1143 –1148.
- 4- Kukuev V.I., Jadua M.H., Domashevskaya E.P.. 2000. Gas sensitive layers with surface modulated conductivity. *Russian chemical and Biological Sensors*: 4 Int (29-31 may 2000). Workshop, Russia, St. Petersburg : 168-169
- 5- Jadua M.H., Kukuev V.I., Rembeza E.S.. 2002. Character of change in electro conductance of sensor layers based on tin dioxide. *J. Perspektivnye materialy*. 1: 20 – 24.
- 6- Kohl D. 1989. Surface processes in the detection of reducing gases with SnO_2 based devices. *J. Sensor and Actuators*. 18.71– 114.

والوصيلية الكهربائية σ لأغشية SnO_2 عند وجود أبخرة الكحول الأثيلي بتركيز $(1-5 \cdot 10^4 \text{ ppm})$ عند درجات الحرارة $^{\circ}\text{C}$ 260 و 360 بعد عملية التشعيع. الشكل رقم 5 يوضح اعتماد التغير في الوصيلية الكهربائية σ على تركيز n و μ في التغير في

$\sigma = \frac{n}{n_0} \sigma_0$ و $\mu = \frac{\mu}{\mu_0} \mu_0$ مع التركيز n و μ للأغشية SnO_2 في الهواء حيث إن كل من n_0 , μ_0 , σ_0 تمثل القيم المقابلة عند وجود الهواء فقط بدون وجود بخار الكحول. بينما القيم n , μ , σ تمثل القيم المقابلة عند وجود بخار الكحول.



شكل (5) : اعتماد الخواص الكهربائية للغشاء SnO_2 (بعد المعاملة بالأشعة الفوتونية ، نموذج رقم 3) على تركيز بخار الكحول الأثيلي عند درجات الحرارة 0C ، (a-260 $^{\circ}\text{C}$) ، (b-360 $^{\circ}\text{C}$) .

من خلال النتائج التجريبية التي حصلنا عليها نلاحظ بان تغير الخواص الكهربائية والتوصيلية الكهربائية مع تغير تركيز الغاز عند درجات

Study of properties of electrical conductivity of Tin dioxide thin films treated with Xenon impulse radiation used as Gas sensors

*Moner H. Jadw**

*Akatarena S. ***

*Stanoslav I. ***

*Wassit University (Iraq).

**Voronezh University of technology (Russia)

Key words: Electrical conductivity, films, Tin dioxide, photons rays, sensitivity, crystallization.

Abstract:

During of Experimental result of this work , we found that the change of electrical conductivity proprieties of tin dioxide with the change of gas concentration at temperatures 260°C and 360°C after treatment by photons rays have similar character after treatment isothermally. We found that intensive short duration impulse annealing during the fractions of a second leads to crystallization of the films and to the high values of its gas sensitivity.